

17-2T-1405

2SD1068は、ガードリング，SIPOS膜等の技術を用いて作られた高電圧増幅，スイッチング用のTr.で複写機，ファクシミリ等の制御回路。ドライブ回路に最適です。

1. 特長
- ・高耐圧 $V_{CBO} 1kV$
 - ・小電流の h_{FE} が高い。 $h_{FE} \geq 30$ at $I_C = 100\mu A$
 - ・2SB832とコンプリメンタリ動作ができる
2. 構造 Si NPN SIPOS Tr.
3. 用途 電圧増幅
4. 外形 TO-220

5. 絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	1000V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	900V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	10V
コレクタ電流(パルス)	I_{CP}	1A
コレクタ電流	I_C	10mA
ベース電流	I_B	5mA
コレクタ損失	$P_C(T_a = 25^\circ C)$	1.1W
"	$P_C(T_c = 25^\circ C)$	25W
接合部温度	T_j	120 $^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-50~+150 $^\circ C$

6. 電気的特性 (Ta=25 °C)

項目	記号	条件	最小値	標準値	最大値	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	$I_C=0.1mA$	1000			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=2mA$	900			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=0.1mA$	10			V
コレクタ遮断電流	I_{CES}	$V_{CE}=1000V, R_{EB}=0$			10	μA
"	I_{CHER}	$V_{CE}=900V, R_{EB}=50k\Omega$			50	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=10V, I_C=0$			2	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=5V, I_C=1mA$	50			
"	h_{FE2}	$V_{CE}=5V, I_C=0.1mA$	30			
コレクタ接合容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_C=0, f=1MHz$		4.5	6	P^F
利得帯域幅積	f_T	$V_{CB}=10V, I_E=1mA$	5	8.5		MHz
スイッチング時間	t_d	Fig.1.		3.2		μS
	t_r	$V_{CC}=500V$		14.0		μS
	t_{stg}	$I_C=1mA$		32.0		μS
	t_r			14.0		μS

7. マーク表示

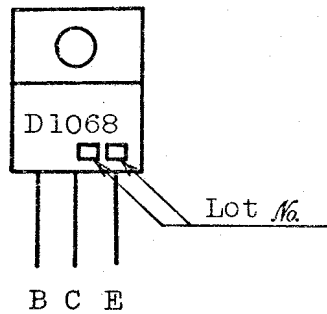
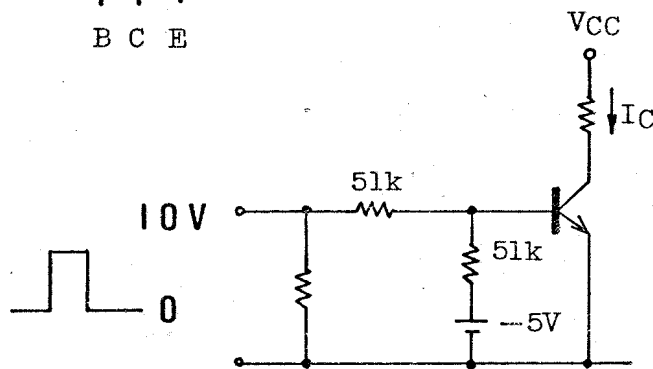
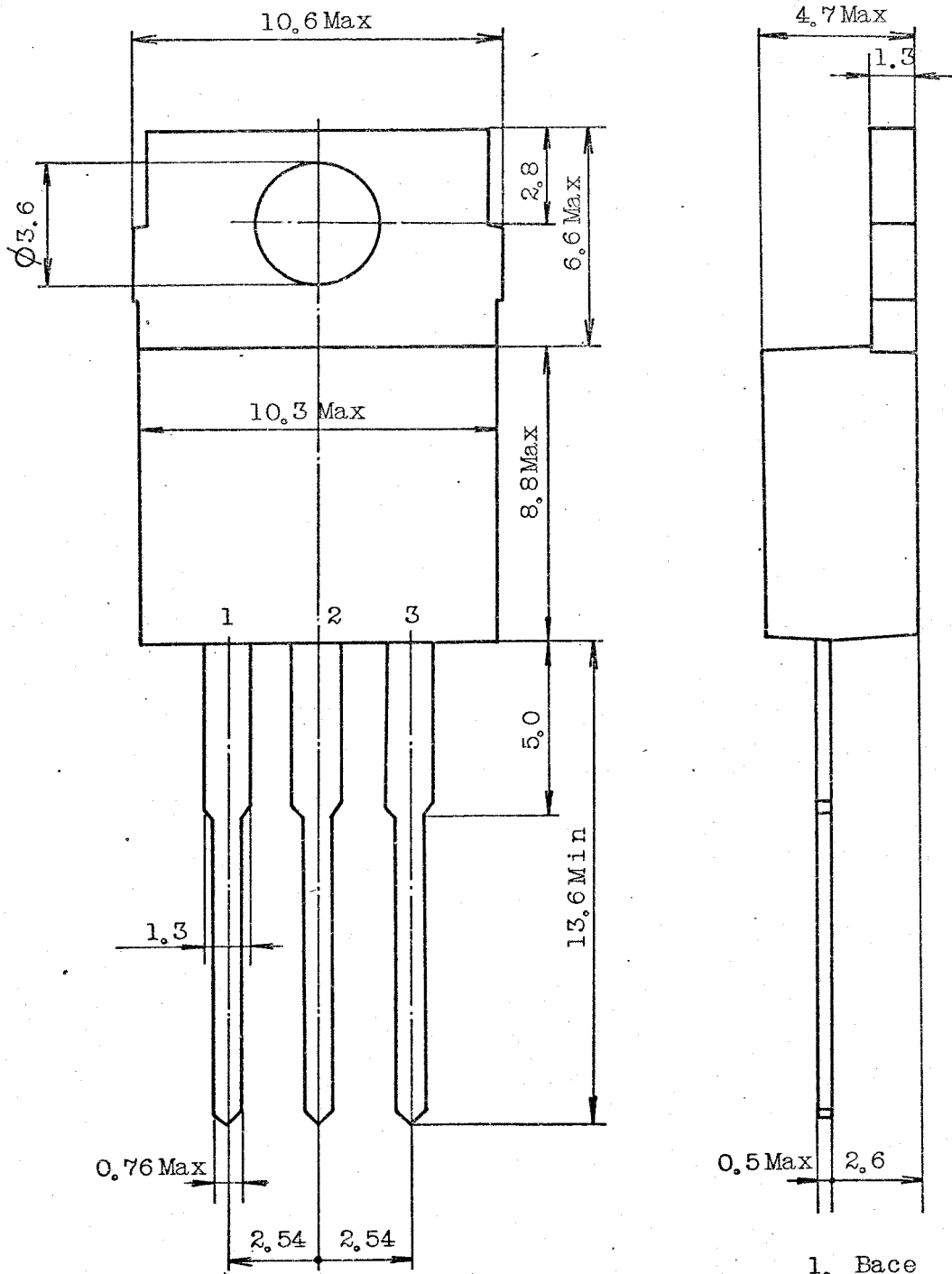


Fig.1



外形図



- 1. Base
- 2. Collector
- 3. Emitter

Unit: mm